

19 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
COURBEVOIE

11 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

3 066 045

21 N° d'enregistrement national : 17 53842

51 Int Cl⁸ : H 01 L 33/04 (2017.01), H 01 L 33/30

12 DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 02.05.17.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la demande : 09.11.18 Bulletin 18/45.

56 Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux apparentés :

Demande(s) d'extension :

71 Demandeur(s) : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public — FR et THALES Société anonyme — FR.

72 Inventeur(s) : ROBIN IVAN-CHRISTOPHE.

73 Titulaire(s) : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public, THALES Société anonyme.

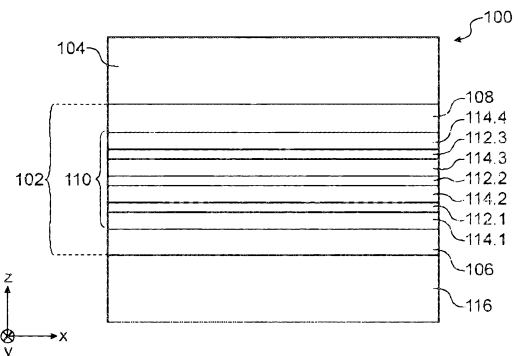
74 Mandataire(s) : BREVALEX Société à responsabilité limitée.

54 DIODE ELECTROLUMINESCENTE COMPRENANT DES COUCHES DE CONVERSION EN LONGUEUR D'ONDE.

57 Diode électroluminescente (100) comprenant:
- une structure d'émission (102) d'une lumière à une première longueur d'onde λ_1 , comportant une jonction p-n (106, 108) dans laquelle est disposée une zone active (110) incluant une première couche émissive (112) comportant de l' $\text{In}_{X_1}\text{Ga}_{1-X_1}\text{N}$ disposée entre deux premières barrières (114);

- une structure de conversion (104) apte à convertir la lumière émise par la structure d'émission à une deuxième longueur d'onde différente de la première, disposée sur la structure d'émission et comprenant une deuxième couche émissive d' $\text{In}_{X_2}\text{Ga}_{1-X_2}\text{N}$, disposée entre deux deuxième barrières comprenant chacune plusieurs couches d'absorption d' $\text{In}_{X_3}\text{Ga}_{1-X_3}\text{N}$ séparées les unes des autres par une intercouche de GaN;

dans laquelle les concentrations en indium X_1 , X_2 et X_3 sont telles que $0 < X_1 < X_2$ et $E_g(\text{In}_{X_2}\text{Ga}_{1-X_2}\text{N}) < E_g(\text{In}_{X_3}\text{Ga}_{1-X_3}\text{N}) < h.c/\lambda_1$.



FR 3 066 045 - A1



DIODE ELECTROLUMINESCENTE COMPRENANT DES COUCHES DE CONVERSION EN LONGUEUR D'ONDE

DESCRIPTION

DOMAINE TECHNIQUE ET ART ANTÉRIEUR

L'invention concerne le domaine des diodes électroluminescentes (appelées DEL ou LED) comprenant un ou plusieurs puits quantiques, ainsi que celui des dispositifs d'affichage comprenant de telles LEDs. L'invention concerne avantageusement une LED apte à émettre une lumière verte et/ou rouge.

Pour réaliser une LED émettant une lumière de couleur verte, ce qui correspond à une émission lumineuse comprise entre environ 500 nm et 580 nm, ou par exemple de l'ordre de 525 nm ou 530 nm, il est connu de former des puits quantiques avec des couches émissives d'InGaN chacune disposée entre deux couches barrières de GaN.

Une telle LED est toutefois peu efficace du fait de la dégradation de la qualité de l'InGaN réalisé quand la quantité d'indium augmente dans les couches émissives (en raison de l'augmentation de la différence de paramètre de maille entre l'InGaN et le GaN lorsque la proportion d'indium dans les couches émissives augmente).

Une manière de contourner ce problème est d'utiliser une LED comportant une première partie formant une structure d'émission apte à émettre une lumière de couleur bleu, par exemple à une longueur d'onde comprise entre environ 440 nm et 450 nm, couplée à une deuxième partie formant une structure de conversion en longueur de la lumière émise par la structure d'émission, et comportant des couches de conversion réalisant une conversion de la lumière bleue en une lumière verte. Une telle structure d'émission émettant une lumière bleue peut être réalisée à partir de puits quantiques dans lesquels les couches émissives comportent de l'InGaN avec un taux, ou une concentration, d'indium de l'ordre de 16%, et dans lesquels les couches barrières comportent du GaN. Les couches de conversion peuvent comporter également des puits quantiques.

Cette approche est particulièrement intéressante dans le cas de dispositifs d'affichage par émission directe car elle permet potentiellement de convertir la lumière bleue sur de faibles épaisseurs. Par exemple, dans le cas d'un micro-écran doté de pixels réalisés avec un pas de l'ordre de 10 μm , la conversion de la lumière bleue en lumière verte est réalisée sur une épaisseur de l'ordre de 10 μm .

Pour réaliser de telles couches de conversion, il est possible d'utiliser des puits quantiques GaN/InGaN. Cependant, de telles couches de conversion se confrontent à deux problèmes :

- Tout d'abord, au sein de la structure de conversion, l'absorption de la lumière bleue émise par la structure d'émission est réalisée uniquement dans les couches émissives d'InGaN. Du fait que ces couches émissives ont une faible épaisseur, la lumière bleue est faiblement absorbée. En raison de cette faible absorption de la lumière reçue par les couches de conversion, pour convertir au moins 80 % de la lumière bleue incidente émise par la LED et reçue par les couches de conversion, il est nécessaire d'utiliser au moins 20 puits quantiques d'InGaN ayant chacun une épaisseur d'environ 3 nm. Avec un tel nombre de puits quantiques, la qualité de l'InGaN peut se dégrader, comme dans des couches épaisses d'InGaN. De plus, ce nombre important de niveaux confinés élargit la bande de longueurs d'ondes d'émission et induit également des problèmes de réabsorption de la lumière, émise depuis un premier puits, par un deuxième puits voisin au premier.

- De plus, pour émettre une lumière verte de longueur d'onde de l'ordre de 525 nm, le taux, ou la concentration, d'indium dans les couches émissives d'InGaN de la structure de conversion est égale à environ 25 %. Avec une telle concentration, il existe une forte différence de paramètre de maille entre l'InGaN des couches émissives et le GaN des couches barrières sur lesquelles les couches émissives sont réalisées. Les couches émissives réalisées sont donc de très mauvaise qualité.

Ainsi, avec de tels puits quantiques GaN/InGaN, les couches de conversion sont inefficaces, les efficacités de conversion (rapport du nombre de photons absorbés sur le nombre de photons réémis à la longueur d'onde souhaitée) obtenues étant inférieures à 20 %.

Des problèmes similaires se posent pour la réalisation d'une LED rouge, ce qui correspond à une émission lumineuse comprise entre environ 590 nm et 800 nm, comprenant des couches de conversion à puits quantiques GaN/InGaN destinées à convertir une lumière bleue en une lumière rouge, du fait que les concentrations en indium dans les couches émissives d'InGaN doivent dans ce cas être de l'ordre de 30 %, voire 40 %.

EXPOSÉ DE L'INVENTION

Un but de la présente invention est de proposer une diode électroluminescente apte à émettre une lumière de couleur verte ou rouge ayant une bonne efficacité de conversion.

Pour cela, la présente invention propose une diode électroluminescente comprenant au moins :

- une structure d'émission d'une lumière à au moins une première longueur d'onde λ_1 , comportant une jonction p-n dans laquelle est disposée une zone active incluant au moins un premier puits quantique formé par une première couche émissive comportant de l' $\text{In}_{x_1}\text{Ga}_{1-x_1}\text{N}$ disposée entre deux premières barrières ;

- une structure de conversion apte à convertir la lumière destinée à être émise par la structure d'émission à au moins une deuxième longueur d'onde λ_2 différente de la première longueur d'onde λ_1 , disposée sur la structure d'émission et comprenant au moins un deuxième puits quantique formé par une deuxième couche émissive d' $\text{In}_{x_2}\text{Ga}_{1-x_2}\text{N}$, disposée entre deux deuxièmes barrières comprenant chacune plusieurs premières couches d'absorption d' $\text{In}_{x_3}\text{Ga}_{1-x_3}\text{N}$ séparées les unes des autres par au moins une première intercouche de GaN ;

dans laquelle les concentrations en indium X_1 , X_2 et X_3 sont telles que $0 < X_1 < X_2$ et $E_g(\text{In}_{x_2}\text{Ga}_{1-x_2}\text{N}) < E_g(\text{In}_{x_3}\text{Ga}_{1-x_3}\text{N}) \leq h.c/\lambda_1$,

avec :

- E_g correspondant au gap, ou à la largeur de bande interdite ;
- h correspondant à constante de Planck égale à environ $6,63.10^{-34}$ J·s ;

- c correspondant à la célérité de la lumière, égale à environ 299 792 428 m/s.

Dans cette LED, la structure de conversion comporte des puits quantiques dans lesquels l'absorption de la lumière émise par la structure d'émission est réalisée non seulement par la ou les deuxièmes couches émissives, mais également par les couches d'absorption des deuxièmes barrières qui comportent de l'InGaN avec une composition en indium égale à X_3 . La réalisation de telles deuxièmes barrières épaisses avec une composition en indium relativement important est possible grâce à la présence des premières intercouches de GaN qui permettent d'obtenir une bonne épaisseur totale d'InGaN sans dégrader la qualité de ce semi-conducteur car lors d'une réalisation des deuxièmes barrières par épitaxie, ces premières intercouches réalisent une « réinitialisation » du paramètre de maille du matériau à faire croître, permettant la réalisation successive de plusieurs couches d'absorption d'InGaN sans dégradation de la qualité du semi-conducteur. Une couche d'InGaN sans intercouche de GaN et ayant une épaisseur équivalente à l'épaisseur des premières couches d'absorption se trouvant d'un côté de la deuxième couche émissive aurait une qualité bien inférieure à celle de ces premières couches d'absorption.

Par exemple, en réalisant la croissance d'une unique couche d' $\text{In}_{0,14}\text{Ga}_{0,86}\text{N}$ d'épaisseur égale à 14 nm sur du GaN, la qualité de l'InGaN réalisé est médiocre car avec une telle concentration d'indium, cette épaisseur est trop importante pour obtenir de l'InGaN de bonne qualité qui permettrait de réaliser une bonne absorption lumineuse. Par contre, en réalisant la croissance d'une première couche d' $\text{In}_{0,14}\text{Ga}_{0,86}\text{N}$ d'épaisseur égale à 7 nm sur du GaN, puis la réalisation d'une intercouche de GaN de quelques monocouches atomiques sur cette première couche d' $\text{In}_{0,14}\text{Ga}_{0,86}\text{N}$, et enfin la croissance d'une deuxième couche d' $\text{In}_{0,14}\text{Ga}_{0,86}\text{N}$ d'épaisseur égale à 7 nm sur l'intercouche de GaN, la qualité du semi-conducteur de cette deuxième couche d' $\text{In}_{0,14}\text{Ga}_{0,86}\text{N}$ est de bonne qualité équivalente à celle de la première couche d' $\text{In}_{0,14}\text{Ga}_{0,86}\text{N}$, du fait que les sept nanomètres d' $\text{In}_{0,14}\text{Ga}_{0,86}\text{N}$ de la deuxième couche sont formés sur du GaN, contrairement aux sept derniers nanomètres de l'unique couche

d'In_{0,14}Ga_{0,86}N d'épaisseur égale à 14 nm qui sont formés sur les sept premiers nanomètres de cette même couche.

En outre, la valeur basse de la concentration en indium X_3 des premières couches d'absorption est fonction de la concentration en indium X_1 dans la première couche émissive ainsi que de l'épaisseur du ou des premiers puits quantiques de la structure d'émission. Plus la concentration en indium X_1 est faible et plus le ou les premiers puits quantiques de la structure d'émission sont fins, plus la valeur de première longueur d'onde λ_1 est faible, ce qui permet d'avoir une concentration en indium X_3 dans les premières couches d'absorption qui soit également faible.

Il est possible d'avoir les concentrations en indium X_1 et X_3 telles que $X_1 < X_3$, ce qui permet d'améliorer l'absorption lumineuse par les premières couches d'absorption. En effet, il est possible d'avoir une énergie d'émission légèrement supérieure à l'énergie du gap $E_g(\text{In}_{x_1}\text{Ga}_{1-x_1}\text{N})$, c'est-à-dire avoir $h.c/\lambda_1 > E_g(\text{In}_{x_1}\text{Ga}_{1-x_1}\text{N})$. Ceci est dû au confinement quantique car l'émission dans la structure d'émission s'effectue à une énergie légèrement supérieure à $E_g(\text{In}_{x_1}\text{Ga}_{1-x_1}\text{N})$. L'énergie $h.c/\lambda_1$ est d'autant supérieure à $E_g(\text{In}_{x_1}\text{Ga}_{1-x_1}\text{N})$ que les puits dans la structure d'émission sont fins.

Toutefois, il est possible d'avoir les concentrations en indium X_1 et X_3 telles que $X_3 < X_1$ du fait du confinement quantique dans les puits de composition X_1 dans la structure émettrice. Cela est avantageux pour ne pas avoir à faire croître des couches d'absorption avec une composition X_3 trop importante. Par exemple, de manière avantageuse, il est possible d'avoir $X_1=0,15$ et $X_3=0,14$ si les puits dans la structure émettrice ont une épaisseur inférieure à environ 2 nm.

Lorsque la première longueur d'onde λ_1 correspond à celle d'une lumière bleue, par exemple comprise entre environ 440 nm et 500 nm, il est possible que la concentration en indium X_3 soit telle que $0,14 \leq X_3$.

Avec de telles deuxièmes barrières, l'épaisseur totale de la structure de conversion peut donc être supérieure ou égale à environ 40 nm sans avoir à réaliser un grand nombre de puits quantiques, ce qui permet à la structure de conversion de réaliser une bonne absorption de la lumière émise par la structure d'émission, et donc d'avoir une bonne efficacité de conversion. En effet, grâce à l'absorption réalisée par les couches

d'absorption, l'efficacité de conversion n'est pas limitée par le transfert des charges vers le ou les deuxièmes puits quantiques de la structure de conversion et dépend des paramètres utilisés pour les propriétés des matériaux en termes de taux de recombinaison Shockley Read Hall (SRH) et Auger.

5 L'épaisseur totale de la structure de conversion, c'est-à-dire l'épaisseur totale du ou des deuxièmes puits quantiques, peut être supérieure ou égale à environ 60 nm, ce qui permet l'obtention d'une meilleure absorption lumineuse par la structure de conversion. De manière avantageuse, cette épaisseur peut être supérieure ou égale à environ 100 nm, voire 200 nm.

10 La structure d'émission peut comporter un ou plusieurs premiers puits quantiques.

La structure de conversion peut comporter un nombre de deuxièmes puits quantiques compris entre 1 et 50. Ainsi, les réabsorptions de la lumière convertie par les autres puits quantiques sont évitées.

15 En ayant la condition $X_1 < X_2$, cela signifie que le gap de l' $\text{In}_{X_2}\text{Ga}_{1-X_2}\text{N}$, noté $E_g(\text{In}_{X_2}\text{Ga}_{1-X_2}\text{N})$, est inférieur à celui de l' $\text{In}_{X_1}\text{Ga}_{1-X_1}\text{N}$, noté $E_g(\text{In}_{X_1}\text{Ga}_{1-X_1}\text{N})$.

La première longueur d'onde est par exemple comprise entre environ 440 nm et 500 nm (spectre correspondant à une lumière bleue), et la deuxième longueur d'onde est par exemple comprise entre environ 500 nm et 580 nm (spectre correspondant à une lumière verte) ou entre environ 590 nm et 800 nm (spectre correspondant à une lumière rouge).

20

Chacune des premières barrières peut comporter une couche de GaN.

La concentration en indium X_1 peut être comprise entre environ 0,09 et 0,18, et par exemple égale à environ 0,15, et/ou la concentration en indium X_2 peut être telle que $X_2 \geq 0,22$, et/ou la concentration en indium X_3 peut être telle que $0,08 \leq X_3 \leq 0,22$ ou avantageusement $0,14 \leq X_3 \leq 0,18$. De manière avantageuse, pour obtenir une conversion en une lumière verte, la concentration en indium X_2 peut être comprise entre environ 0,22 et 0,25, et par exemple égale à environ 0,25 pour obtenir une conversion à une deuxième longueur d'onde d'environ 530 nm. Pour obtenir une conversion en une

25

30 lumière rouge, la concentration en indium X_2 peut être comprise entre environ 0,3 et 0,4,

et par exemple égale à environ 0,35 pour obtenir une conversion à une deuxième longueur d'onde d'environ 620 nm.

Chaque première couche d'absorption qui n'est pas disposée contre la deuxième couche émissive peut avoir une épaisseur inférieure à 9 nm, et/ou l'épaisseur totale de la deuxième couche émissive et de deux premières couches d'absorption disposées contre la deuxième couche émissive peut être inférieure à 9 nm. Ainsi, au sein de la structure de conversion, il n'est pas réalisé de manière continue de l'InGaN sur une épaisseur supérieure à 9 nm, ce qui permet d'éviter toute dégradation de cet InGaN.

Chaque première intercouche de GaN peut avoir une épaisseur comprise entre 1 et 4 monocouches atomiques, et avantageusement comprise entre 1 et 2 monocouches atomiques.

Chacune des deuxièmes barrières peut comporter deux premières couches d'absorption et une première intercouche.

La structure de conversion peut comporter au moins un troisième puits quantique formé par une troisième couche émissive d' $\text{In}_{X_4}\text{Ga}_{1-X_4}\text{N}$, disposée entre deux troisièmes barrières comprenant chacune plusieurs deuxièmes couches d'absorption d' $\text{In}_{X_5}\text{Ga}_{1-X_5}\text{N}$ séparées les unes des autres par au moins une deuxième intercouche de GaN, dans laquelle les concentrations en indium X_4 et X_5 sont telles que $X_1 < X_4$ et $E_g(\text{In}_{X_4}\text{Ga}_{1-X_4}\text{N}) < E_g(\text{In}_{X_5}\text{Ga}_{1-X_5}\text{N}) \leq h.c/\lambda_1$, avec X_2 de valeur différente de celle de X_4 . Une telle structure de conversion peut donc être polychrome, c'est-à-dire apte à convertir la lumière émise par la structure d'émission en au moins deux longueurs d'onde différente ou deux gammes de longueurs d'onde différentes.

La concentration en indium X_2 peut être comprise entre 0,22 et 0,25, et la concentration en indium X_4 peut être comprise entre 0,3 et 0,4.

L'invention porte également sur un procédé de réalisation d'au moins une diode électroluminescente, comprenant au moins :

- réalisation d'une structure d'émission d'une lumière à au moins une première longueur d'onde λ_1 , comportant une jonction p-n dans laquelle est disposée une zone active incluant au moins un premier puits quantique formé par une première couche émissive comportant de l' $\text{In}_{X_1}\text{Ga}_{1-X_1}\text{N}$ disposée entre deux premières barrières ;

- réalisation d'une structure de conversion apte à convertir la lumière destinée à être émise par la structure d'émission à au moins une deuxième longueur d'onde λ_2 différente de la première longueur d'onde λ_1 , disposée sur la structure d'émission et comprenant au moins un deuxième puits quantique formé par une deuxième couche émissive d' $\text{In}_{x_2}\text{Ga}_{1-x_2}\text{N}$, disposée entre deux deuxième barrières comprenant chacune plusieurs premières couches d'absorption d' $\text{In}_{x_3}\text{Ga}_{1-x_3}\text{N}$ séparées les unes des autres par au moins une première intercouche de GaN ;

dans lequel les concentrations en indium X_1 , X_2 et X_3 sont telles que $0 < X_1 < X_2$ et $E_g(\text{In}_{x_2}\text{Ga}_{1-x_2}\text{N}) < E_g(\text{In}_{x_3}\text{Ga}_{1-x_3}\text{N}) \leq h.c/\lambda_1$,

avec :

- E_g correspondant au gap, ou à la largeur de bande interdite ;
- h correspondant à constante de Planck égale à environ $6,63.10^{-34}$ J·s ;
- c correspondant à la célérité de la lumière, égale à environ

299 792 428 m/s.

Les couches de la structure d'émission et de la structure de conversion peuvent être réalisées par épitaxie.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description d'exemples de réalisation donnés à titre purement indicatif et nullement limitatif en faisant référence aux dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 représente une diode électroluminescente, objet de la présente invention, selon un mode de réalisation particulier ;

- les figures 2 et 3 représentent des exemples de réalisation d'une structure de conversion d'une diode électroluminescente, objet de la présente invention.

Des parties identiques, similaires ou équivalentes des différentes figures décrites ci-après portent les mêmes références numériques de façon à faciliter le passage d'une figure à l'autre.

Les différentes parties représentées sur les figures ne le sont pas nécessairement selon une échelle uniforme, pour rendre les figures plus lisibles.

Les différentes possibilités (variantes et modes de réalisation) doivent être comprises comme n'étant pas exclusives les unes des autres et peuvent se combiner entre elles.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS

5 On se réfère tout d'abord à la figure 1 qui représente une diode électroluminescente, ou LED, 100 selon un mode de réalisation particulier.

Dans la notation $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ utilisée dans le présent document, X représente la composition en indium, ou concentration en indium, du matériau semi-conducteur, c'est-à-dire la proportion d'indium par rapport à la quantité totale d'indium et de gallium dans l' $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$. En outre, la caractéristique $E_g(\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N})$ correspond au
10 gap, ou largeur de bande interdite, du semi-conducteur $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$.

La LED 100 est formée de deux parties : une première partie formant une structure d'émission 102 apte à émettre une lumière comprenant au moins une première longueur d'onde λ_1 , ou une première gamme de longueurs d'onde, et une
15 deuxième partie formant une structure de conversion 104 disposée sur la structure d'émission 102 et apte à convertir la lumière émise par la structure d'émission 102 en une lumière comprenant au moins une deuxième longueur d'onde λ_2 différente de la première longueur d'onde, ou une deuxième gamme de longueurs d'onde différente de la première gamme de longueurs d'onde.

20 La structure d'émission 102 correspond à une structure classique de LED, et comporte une jonction p-n formée par une première couche 106 comprenant du GaN dopé n (GaN-n) avec une concentration de donneurs par exemple égale à environ 10^{19} donneurs/cm³ et une deuxième couche 108 comprenant du GaN dopé p (GaN-p) avec une concentration d'accepteurs par exemple égale à environ 10^{19} accepteurs/cm³.
25 Ces deux couches 106 et 108 ont par exemple chacune une épaisseur (dimension selon l'axe Z représenté sur la figure 1) comprise entre environ 20 nm et 10 μm . De manière générale, la première couche 106 peut avoir une concentration de donneurs comprise entre

environ 10^{17} et 10^{20} donneurs/cm³, et la deuxième couche 108 peut avoir une concentration d'accepteurs comprise entre environ 10^{15} et 10^{20} accepteurs/cm³.

En variante, il est possible que la première couche 106 comporte de l'InGaN-n, avec une concentration en indium comprise par exemple entre 0 et environ 20 %. En outre, lorsque la concentration en indium dans l'InGaN de la première couche 106 est non nulle, la deuxième couche 108 peut comporter de l'InGaN-p. Dans ce cas, la concentration en indium dans l'InGaN de la deuxième couche 108 est avantageusement inférieure à la concentration en indium dans l'InGaN de la première couche 106, et par exemple comprise entre environ 0 % et 15 %.

La structure d'émission 102 comporte, entre les couches 106 et 108, une zone active 110 formée de semi-conducteur intrinsèque comprenant au moins un premier puits quantique formé par une première couche émissive 112 disposée entre deux premières barrières 114. Dans le mode de réalisation particulier décrit ici, la structure d'émission 102 comporte trois premières couches émissives 112, référencées 112.1, 112.2 et 112.3. De manière générale, la structure émissive 102 peut comporter n premières couches émissives 112, avec n nombre entier tel que $n \geq 1$, et avantageusement tel que $3 \leq n \leq 6$. De plus, les premières couches émissives 112 comportent de l'In_{x1}Ga_{1-x1}N. Le semi-conducteur des premières couches émissives 112 est non intentionnellement dopé (de concentration en donneurs résiduels par exemple telle que $n_{nid} = 10^{17}$ donneurs/cm³). Enfin, chacune des premières couches émissives 112 a une épaisseur par exemple égale à environ 3 nm, ou comprise entre 1 nm et 5 nm.

Le taux d'indium de l'InGaN des premières couches émissives 112 peut être différent d'une couche à l'autre, la structure d'émission 102 étant dans ce cas apte à émettre selon des longueurs d'ondes différentes d'une première couche émissive 112 à l'autre. Mais de manière avantageuse, les concentrations en indium dans l'InGaN des premières couches émissives 112 sont similaires d'une première couche émissive à l'autre, la structure d'émission 102 étant dans ce cas apte à émettre une lumière monochromatique. Dans tous les cas, la valeur de la concentration en indium au sein de la ou des premières couches émissives 112 est choisie en fonction de la ou des longueurs d'ondes destinées à être émises.

Dans le mode de réalisation particulier décrit ici, les premières couches émissives 112 comportent de l' $\text{In}_{0,16}\text{Ga}_{0,84}\text{N}$ (c'est-à-dire comprenant une proportion de 16 % d'indium pour 84 % de gallium), ou plus généralement de l' $\text{In}_{X_1}\text{Ga}_{1-X_1}\text{N}$ avec X_1 compris entre environ 0,09 et 0,18. De telles premières couches émissives 112 permettent à la structure d'émission 102 d'émettre une lumière de couleur bleu.

La zone active 110 de la structure d'émission 102 comporte également des premières barrières 114 (au nombre de quatre dans la structure d'émission 102 représentée sur la figure 1, et référencées 114.1, 114.2, 114.3 et 114.4) comprenant par exemple du GaN non intentionnellement dopé (de concentration en donneurs résiduels par exemple telle que $n_{\text{nid}} = 10^{17}$ donneurs/cm³), d'épaisseur par exemple égale à environ 8 nm. Deux des quatre premières barrières 114 sont interposées chacune entre deux premières couches émissives 112 consécutives, et les deux autres premières barrières 114 sont chacune interposée entre une des premières couches émissives 112 et l'une des couches 106 et 108. Ainsi, la première barrière 114.1 est disposée entre la première couche 106 et la première couche émissive 112.1. La première barrière 114.2 est disposée entre les premières couches émissives 112.1 et 112.2. La première barrière 114.3 est disposée entre les premières couches émissives 112.2 et 112.3. La première barrière 114.4 est disposée entre la première couche émissive 112.3 et la deuxième couche 108. Chaque première couche émissive 112 et les deux premières barrières 114 entre lesquelles se trouve cette première couche émissive 112 forment un premier puits quantique.

En variante, il est possible que les premières barrières 114 ne comportent pas du GaN mais de l'InGaN. Dans ce cas, les valeurs des concentrations en indium du semi-conducteur des premières barrières 114 sont inférieures à celles du semi-conducteur des premières couches émissives 112 et donc par exemple comprises entre environ 0,01 et 0,1.

De manière générale, la structure d'émission 102 qui comporte n premières couches émissives 112, avec n nombre entier supérieur ou égal à 1, comporte donc $n+1$ premières barrières 114. La zone active 110 est formée de l'empilement alterné des n premières couches émissives 112 et des $n+1$ premières barrières 114. Les couches

112 et 114 peuvent avoir des concentrations en donneurs résiduels comprises entre environ 10^{16} et 10^{20} donneurs/cm³.

Les couches de la zone active 110 sont réalisées par épitaxie, par exemple MOCVD, sur une couche épaisse 116 de GaN formant le substrat de croissance.

5 En variante, la couche 116 peut comporter de l'InGaN. Dans ce cas, la structure d'émission 102 peut avantageusement correspondre à une structure entièrement formée d'InGaN, c'est-à-dire dont les couches 116, 106, 112, 114 et 108 comportent de l'InGaN.

10 En variante, une couche d'AlGaN dopée p peut être interposée entre la couche 108 et la zone active 110. Cette couche d'AlGaN peut comporter une concentration égale à environ 10^{19} accepteurs/cm³, une concentration d'aluminium comprise entre environ 5 % et 25 %, et une épaisseur comprise entre environ 5 nm et 100 nm. Une telle couche d'AlGaN permet de bloquer un courant d'électrons fuyant de la zone active vers le côté p de la jonction, c'est-à-dire la deuxième couche 108.

15 Un premier exemple de réalisation de la structure de conversion 104 de la LED 100 est représenté schématiquement sur la figure 2.

La structure de conversion 104 comporte un ou plusieurs deuxièmes puits quantiques qui sont destinés à réaliser une conversion de la ou des premières longueurs d'onde de la lumière émise par la structure d'émission 102 en une lumière
20 comprenant une deuxième longueur d'onde ou une deuxième gamme de longueurs d'onde, différente de la première. Chacun des deuxièmes puits quantiques est formé par une deuxième couche émissive 118 disposée entre deux deuxièmes barrières 120. Dans le premier exemple de réalisation particulier décrit ici, la structure de conversion 104 comporte deux deuxièmes couches émissives 118, référencées 118.1 et 118.2, chacune
25 disposée entre deux deuxièmes barrières 120, référencées 120.1, 120.2 et 120.3, formant ainsi deux deuxièmes puits quantiques. De manière générale, la structure de conversion 104 peut comporter m deuxièmes couches émissives 118, avec m nombre entier tel que $m \geq 1$, et avantageusement tel que $1 \leq m \leq 5$.

30 La deuxième barrière 120.1 est disposée entre la structure d'émission 102 et la deuxième couche émissive 118.1. La deuxième barrière 120.2 est disposée entre

les deuxièmes couches émissives 118.1 et 118.2. La deuxième barrière 120.3 est disposée sur la deuxième couche émissive 118.2 et forme la face par laquelle la lumière dont la longueur d'onde a été convertie est destinée à être émise par la LED 100.

Les deuxièmes couches émissives 118 comportent de l' $\text{In}_{X_2}\text{Ga}_{1-X_2}\text{N}$. Dans le premier exemple de réalisation décrit ici, la concentration en indium X_2 de l' InGaN des deuxièmes couches émissives 118 est supérieure à environ 22 %, ici égale à environ 25 %. Ainsi, la lumière émise par la structure d'émission 102 est convertie en une lumière verte.

Le semi-conducteur des deuxièmes couches émissives 118 est non intentionnellement dopé (de concentration en donneurs résiduels par exemple telle que $n_{\text{nid}} = 10^{17}$ donneurs/ cm^3). Enfin, chacune des deuxièmes couches émissives 118 a une épaisseur par exemple comprise entre environ 1 nm et 5 nm.

Contrairement aux premières barrières 114 qui sont chacune formées par une seule couche de matériau, chacune des deuxièmes barrières 120 est formée d'un empilement de plusieurs couches de matériaux distincts. Chacune des deuxièmes barrières 120 comporte plusieurs couches d'absorption d' $\text{In}_{X_3}\text{Ga}_{1-X_3}\text{N}$ 122 séparées les unes des autres par au moins une intercouche de GaN 124. Sur l'exemple de réalisation de la figure 2, chacune des deuxièmes barrières 120 comporte trois couches d'absorption 122 séparées les unes des autres par deux intercouches 124. La concentration en indium X_3 de l' InGaN des couches d'absorption 122 est telle que $E_g(\text{In}_{X_2}\text{Ga}_{1-X_2}\text{N}) < E_g(\text{In}_{X_3}\text{Ga}_{1-X_3}\text{N}) \leq h.c/\lambda_1$. Dans le cas d'une structure d'émission 102 émettant une lumière bleue, la concentration en indium X_3 de l' InGaN des couches d'absorption 122 peut être telle que $0,14 \leq X_3 < X_2$.

Contrairement aux couches barrières de GaN comme par exemple celles utilisées dans la structure d'émission 102, les deuxièmes barrières 120 comportent de l' InGaN avec une concentration en indium supérieure ou égale à celle de l' InGaN des deuxièmes couches émissives 118. L' InGaN des deuxièmes barrières 120 est également le matériau formant les couches d'absorption 122. Ainsi, l'absorption de la lumière émise par la structure d'émission 102 est absorbée non seulement par les deuxièmes couches émissives 118, mais également par les couches d'absorption 122 présentes dans les deuxièmes barrières 120.

En outre, l'épaisseur totale des deuxièmes puits quantiques, c'est-à-dire l'épaisseur totale de la structure de conversion 104 (dimension parallèle à l'axe Z de la figure 2) est ici supérieure ou égale à environ 40 nm, ce qui permet à la structure de conversion 104 de réaliser une bonne absorption de la lumière émise par la structure d'émission 102 pour réaliser une conversion de la ou des longueurs d'onde présentes dans cette lumière. Dans le mode de réalisation particulier décrit ici, étant donné les concentrations en indium X_1 et X_2 précédemment mentionnées, la LED 100 est apte à émettre une lumière verte grâce à la conversion de la lumière bleue émise par la structure d'émission 104 en lumière verte par la structure de conversion 104.

De manière avantageuse, l'épaisseur de la structure de conversion 104 est supérieure ou égale à environ 60 nm, ou supérieure ou égale à environ 100 nm, voire supérieure ou égale à environ 200 nm, ce qui augmente encore l'absorption réalisée par la structure de conversion 104 vis-à-vis de la lumière émise par la structure d'émission 102 du fait qu'une telle épaisseur implique la présence d'une épaisseur plus importante de matériau absorbant la lumière émise par la structure d'émission 102.

Cette épaisseur importante de la structure de conversion 104 est possible grâce à la présence des intercouches 124 de GaN qui, lors de la réalisation des deuxièmes barrières 120 par épitaxie, réalisent une relaxation du paramètre de maille et permettent donc d'obtenir une épaisseur totale d'InGaN bien supérieure à ce qu'il serait possible de réaliser en l'absence de ces intercouches de GaN.

En outre, afin que l'InGaN des couches d'absorption 122 et des deuxièmes couches émissives 118 soit une bonne qualité, l'épaisseur d'InGaN se trouvant entre deux intercouches 124 successives (c'est-à-dire l'épaisseur d'une des couches d'absorption 122, ou celle d'une des deuxièmes couches émissives 118 et des deux couches d'absorption 122 adjacentes) est de préférence inférieure à environ 9 nm. De plus, l'épaisseur de chaque intercouche 124 de GaN est par exemple comprise entre 1 et 4 monocouches atomiques, et de préférence comprise entre 1 et 2 monocouches atomiques.

Avec la structure de conversion 104 représentée sur la figure 2, ayant une épaisseur totale de 80 nm, et comportant deux deuxièmes couches émissives 118

d' $\text{In}_{0,25}\text{Ga}_{0,75}\text{N}$, des intercouches 124 de GaN (deux de chaque côté de chacune des deuxièmes couches émissives 118), et des couches d'absorption 122 d' $\text{In}_{0,14}\text{Ga}_{0,86}\text{N}$ entre lesquelles sont disposées les intercouches 124, celle-ci peut absorber environ 80 % d'un flux incident de 100 W/cm^2 . En réalisation une structure de conversion 104 ayant une

5 épaisseur totale de 140 nm, et comportant deux deuxièmes couches émissives 118 d' $\text{In}_{0,25}\text{Ga}_{0,75}\text{N}$, des intercouches 124 de GaN (quatre de chaque côté de chacune des deuxièmes couches émissives 118), et des couches d'absorption 122 d' $\text{In}_{0,14}\text{Ga}_{0,86}\text{N}$ entre lesquelles sont disposées les intercouches 124, cette structure peut absorber environ 97 % d'un flux incident de 100 W/cm^2 .

10 Les efficacités de conversion obtenues sont par exemple comprises entre environ 76 % et 80 % en fonction du flux incident.

La figure 3 représente un deuxième exemple de réalisation de la structure de conversion 104. Dans ce deuxième exemple de réalisation, chaque deuxième barrière 120 comporte une seule intercouche 124 de GaN. Pour une épaisseur totale

15 équivalente à celle de la structure de conversion 104 selon le premier exemple de réalisation, la structure de conversion 104 selon ce deuxième exemple de réalisation comporte un nombre plus important de puits quantiques, ici cinq. Les différentes variantes décrites précédemment en lien avec le premier exemple de réalisation peuvent s'appliquer également à ce deuxième exemple de réalisation.

20 Selon une variante de réalisation, la structure de conversion 104 peut être polychrome. Une telle structure comporte, en plus du ou des deuxièmes puits quantiques qui sont aptes à convertir la lumière (comportant une première longueur d'onde ou une première gamme de longueurs d'onde) émise par la structure d'émission 102 en une lumière comportant une deuxième longueur d'onde ou une deuxième gamme

25 de longueurs d'onde, par exemple de couleur verte, un ou plusieurs troisièmes puits quantiques aptes à convertir la lumière émise par la structure d'émission 102 en une lumière comportant une troisième longueur d'onde ou une troisième gamme de longueurs d'onde, différente de la deuxième longueur d'onde ou de la deuxième gamme de longueurs d'onde. Cette différence de conversion entre les puits quantiques est

obtenue en réalisant les couches émissives de ces puits avec de l'InGaN comportant des concentrations d'indium différentes.

Une telle structure de conversion 104 polychrome correspond par exemple à une structure similaire à celle représentée sur la figure 2, dans laquelle la concentration d'indium de l'InGaN de la couche émissive 118.1 est différente de celle de l'InGaN de la couche émissive 118.2. Ainsi, la couche émissive 118.1 et les barrières 120.1 et 120.2 peuvent former un puits quantique dans lequel l' $\text{In}_{X_2}\text{Ga}_{1-X_2}\text{N}$ de la couche émissive 118.1 est tel que $X_2 = 0,25$ afin que ce puits quantique réalise une conversion à une longueur d'onde d'environ 530 nm (lumière verte), et la couche émissive 118.2 et les barrières 120.2 et 120.3 peuvent former un puits quantique dans lequel l' $\text{In}_{X_4}\text{Ga}_{1-X_4}\text{N}$ de la couche émissive 118.2 est tel que $X_4 = 0,35$ afin que ce puits quantique réalise une conversion à une longueur d'onde d'environ 620 nm (lumière rouge).

De manière analogue, la structure de conversion 104 représentée sur la figure 3 peut correspondre à une structure de conversion polychrome, avec dans ce cas un ou plusieurs des puits quantiques de cette structure réalisant une conversion à une certaine longueur d'onde et le ou les autres puits quantiques réalisant une conversion à une autre longueur d'onde.

Il est également possible que la structure de conversion réalise une conversion de lumière polychrome selon plus de deux longueurs d'onde, ou plus de deux gammes de longueurs d'onde, lorsque cette structure comporte plus de deux puits quantiques.

Dans les exemples de réalisation et variantes décrits ci-dessus, la composition en indium dans l'InGaN des différentes couches est sensiblement constante au sein de cette ou chacune de ces couches. En variante, il est possible que la composition en indium d'une ou plusieurs des couches de la structure de conversion 104 et/ou de la structure d'émission 102 varie entre deux valeurs, selon la direction dans laquelle les différentes couches de la LED 100 sont empilées (c'est-à-dire parallèlement à l'axe Z). Ces variations sont toutefois telles que les conditions précédemment exposées sur

les concentrations en indium X_1 , X_2 et X_3 sont toujours vérifiées, c'est-à-dire telles que $0 < X_1 < X_2$ et $E_g(\text{In}_{X_2}\text{Ga}_{1-X_2}\text{N}) < E_g(\text{In}_{X_3}\text{Ga}_{1-X_3}\text{N}) \leq h.c/\lambda_1$.

A partir de la structure de la LED 100 telle que représentée sur la figure 1, des électrodes sont ensuite réalisées telles qu'elles soient reliées électriquement aux première et deuxième couches 106, 108.

La LED 100 précédemment décrite peut être réalisée sous la forme d'une diode planaire, c'est-à-dire sous la forme d'un empilement de couches formées par exemple par épitaxie sur un substrat, comme représenté sur la figure 1, les faces principales des différentes couches étant disposées parallèlement au plan du substrat (parallèle au plan (X,Y)). En variante, la LED 100 peut également être réalisée sous la forme d'un nanofil, axial ou radial, comme décrit par exemple dans le document WO 2014/154690 A1.

REVENDEICATIONS

1. Diode électroluminescente (100) comprenant au moins :

- une structure d'émission (102) d'une lumière à au moins une première longueur d'onde λ_1 , comportant une jonction p-n (106, 108) dans laquelle est disposée une zone active (110) incluant au moins un premier puits quantique formé par une première couche émissive (112) comportant de $\text{In}_{x_1}\text{Ga}_{1-x_1}\text{N}$ disposée entre deux premières barrières (114) ;
- une structure de conversion (104) apte à convertir la lumière destinée à être émise par la structure d'émission (102) à au moins une deuxième longueur d'onde λ_2 différente de la première longueur d'onde λ_1 , disposée sur la structure d'émission (102) et comprenant au moins un deuxième puits quantique formé par une deuxième couche émissive (118) d' $\text{In}_{x_2}\text{Ga}_{1-x_2}\text{N}$, disposée entre deux deuxièmes barrières (120) comprenant chacune plusieurs premières couches d'absorption (122) d' $\text{In}_{x_3}\text{Ga}_{1-x_3}\text{N}$ séparées les unes des autres par au moins une première intercouche (124) de GaN ;

dans laquelle les concentrations en indium X_1 , X_2 et X_3 sont telles que $0 < X_1 < X_2$ et $E_g(\text{In}_{x_2}\text{Ga}_{1-x_2}\text{N}) < E_g(\text{In}_{x_3}\text{Ga}_{1-x_3}\text{N}) \leq h.c/\lambda_1$,

avec :

- E_g correspondant au gap, ou à la largeur de bande interdite ;
- h correspondant à constante de Planck égale à environ $6,63.10^{-34}$ J·s ;
- c correspondant à la célérité de la lumière, égale à environ 299 792 428 m/s.

25

2. Diode électroluminescente (100) selon la revendication 1, dans laquelle l'épaisseur totale de la structure de conversion (104) est supérieure ou égale à 40 nm, ou supérieure ou égale à 60 nm.

3. Diode électroluminescente (100) selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle les concentrations en indium X_1 et X_3 sont telles que $X_1 < X_3$.

5 4. Diode électroluminescente (100) selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle la structure de conversion comporte un nombre de deuxièmes puits quantiques compris entre 1 et 50.

10 5. Diode électroluminescente (100) selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle chacune des premières barrières (114) comporte une couche de GaN.

15 6. Diode électroluminescente (100) selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle la concentration en indium X_1 est comprise entre environ 0,09 et 0,18, et/ou dans laquelle la concentration en indium X_2 est telle que $X_2 \geq 0,22$, et/ou dans laquelle la concentration en indium X_3 est telle que $0,08 \leq X_3 \leq 0,22$.

20 7. Diode électroluminescente (100) selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle chaque première couche d'absorption (122) qui n'est pas disposée contre la deuxième couche émissive (118) a une épaisseur inférieure à 9 nm, et/ou dans laquelle l'épaisseur totale de la deuxième couche émissive (118) et de deux premières couches d'absorption (122) disposées contre la deuxième couche émissive (118) est inférieure à 9 nm.

25 8. Diode électroluminescente (100) selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle chaque première intercouche (124) a une épaisseur comprise entre 1 et 4 monocouches atomiques.

30 9. Diode électroluminescente (100) selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle chacune des deuxièmes barrières (120) comporte deux premières couches d'absorption (122) et une première intercouche (124).

10. Diode électroluminescente (100) selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle la structure de conversion (104) comporte au moins un troisième puits quantiques formé par une troisième couche émissive (118) d' $\text{In}_{X_4}\text{Ga}_{1-X_4}\text{N}$,
5 disposée entre deux troisièmes barrières (120) comprenant chacune plusieurs deuxième couches d'absorption (122) d' $\text{In}_{X_5}\text{Ga}_{1-X_5}\text{N}$ séparées les unes des autres par au moins une deuxième intercouche (124) de GaN, dans laquelle les concentrations en indium X_4 et X_5 sont telles que $X_1 < X_4$ et $E_g(\text{In}_{X_4}\text{Ga}_{1-X_4}\text{N}) < E_g(\text{In}_{X_5}\text{Ga}_{1-X_5}\text{N}) \leq h.c/\lambda_1$, avec X_2 de valeur différente de celle de X_4 .

10

11. Diode électroluminescente (100) selon la revendication 10, dans laquelle la concentration en indium X_2 est comprise entre 0,22 et 0,25, et dans laquelle la concentration en indium X_4 est comprise entre 0,3 et 0,4.

15

12. Procédé de réalisation d'au moins une diode électroluminescente (100), comprenant au moins :

- réalisation d'une structure d'émission (102) d'une lumière à au moins une première longueur d'onde λ_1 , comportant une jonction p-n (106, 108) dans laquelle est disposée une zone active (110) incluant au moins un premier puits quantique formé
20 par une première couche émissive (112) comportant de l' $\text{In}_{X_1}\text{Ga}_{1-X_1}\text{N}$ disposée entre deux premières barrières (114) ;

20

- réalisation d'une structure de conversion (104) apte à convertir la lumière destinée à être émise par la structure d'émission (102) à au moins une deuxième longueur d'onde λ_2 différente de la première longueur d'onde λ_1 , disposée sur la
25 structure d'émission (102) et comprenant au moins un deuxième puits quantique formé par une deuxième couche émissive (118) d' $\text{In}_{X_2}\text{Ga}_{1-X_2}\text{N}$, disposée entre deux deuxième barrières (120) comprenant chacune plusieurs premières couches d'absorption (122) d' $\text{In}_{X_3}\text{Ga}_{1-X_3}\text{N}$ séparées les unes des autres par au moins une première intercouche (124) de GaN ;

25

dans lequel les concentrations en indium X_1 , X_2 et X_3 sont telles que $0 < X_1 < X_2$ et $E_g(\text{In}_{X_2}\text{Ga}_{1-X_2}\text{N}) < E_g(\text{In}_{X_3}\text{Ga}_{1-X_3}\text{N}) \leq h.c/\lambda_1$,

avec :

- E_g correspondant au gap, ou à la largeur de bande interdite ;
- 5 - h correspondant à constante de Planck égale à environ $6,63.10^{-34}$ J·s ;
- c correspondant à la célérité de la lumière, égale à environ 299 792 428 m/s.

10 13. Procédé de réalisation selon la revendication 12, dans lequel les couches (106, 108, 112, 114, 118, 122, 124) de la structure d'émission (102) et de la structure de conversion (104) sont réalisées par épitaxie.

1/2

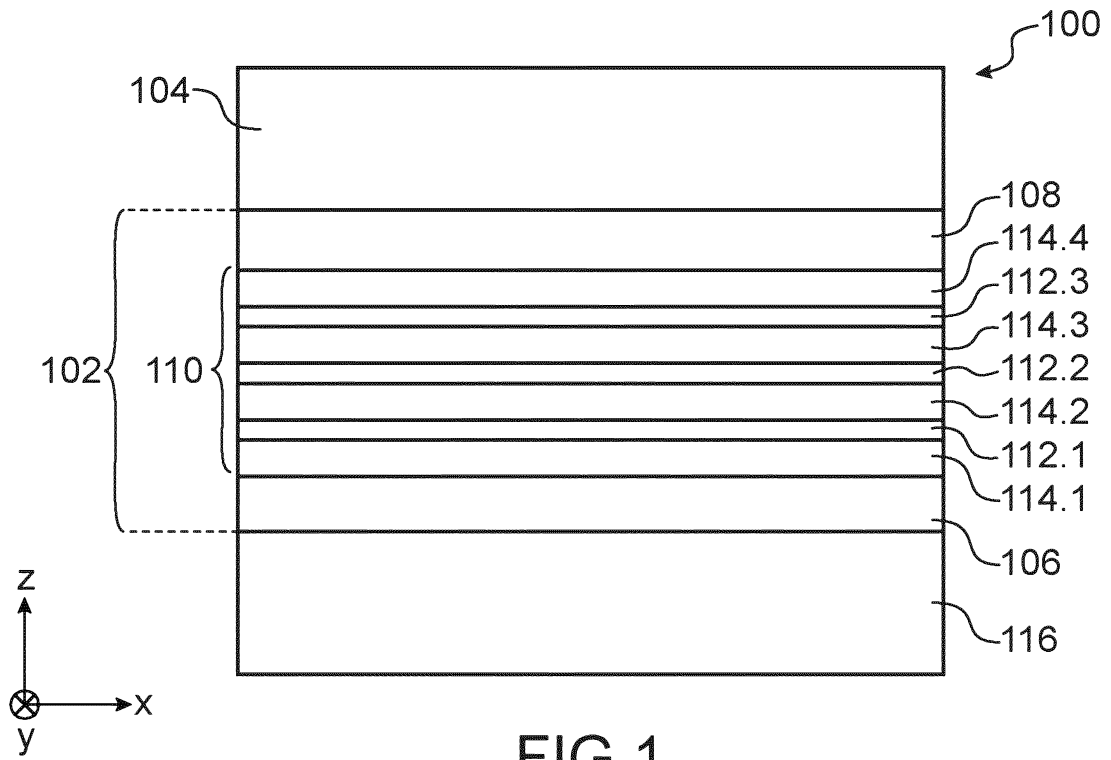


FIG. 1

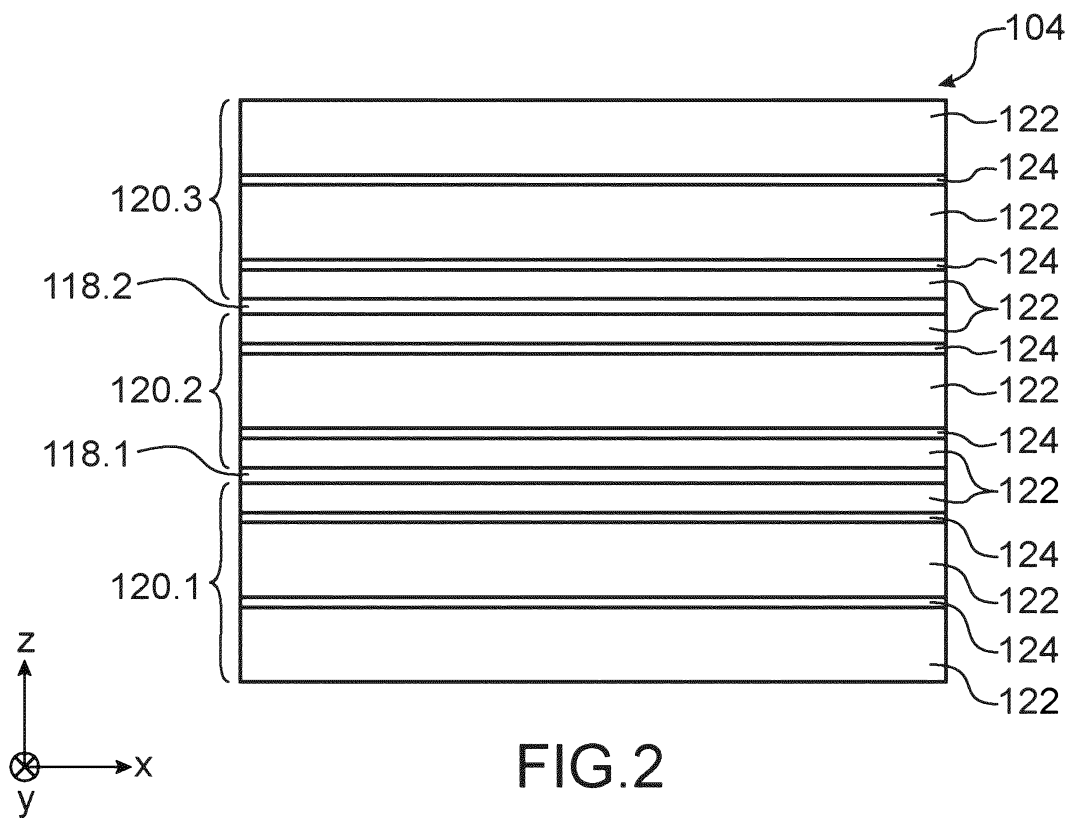
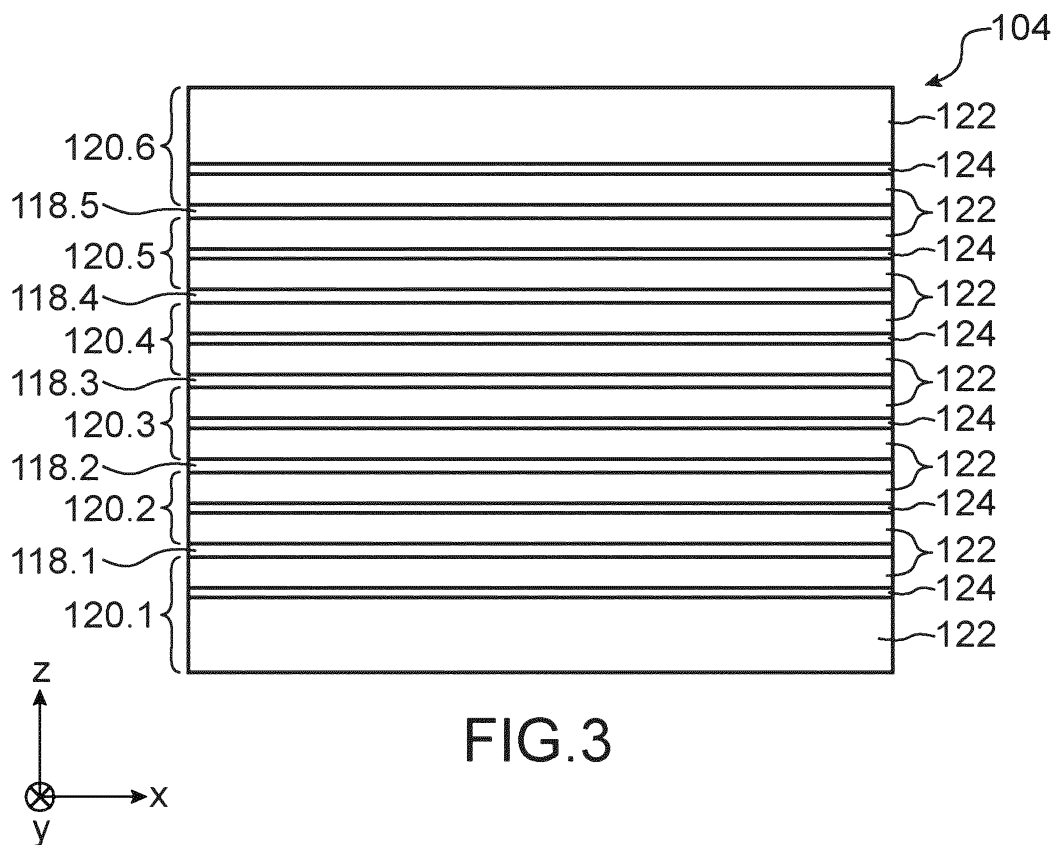


FIG. 2

2/2





**RAPPORT DE RECHERCHE
PRÉLIMINAIRE**

N° d'enregistrement
national

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

FA 842393
FR 1753842

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A	US 2013/049569 A1 (SCHUBERT MARTIN F [US] ET AL) 28 février 2013 (2013-02-28) * alinéas [0001] - [0004]; figures 1A-C * * alinéas [0017], [0023] - [0033]; figures 2, 4-7B *	1-13	H01L33/04 H01L33/30
A	US 2011/045623 A1 (MASSIES JEAN [FR] ET AL) 24 février 2011 (2011-02-24) * alinéas [0008], [0026] - [0030]; figure 1; tableau 1 * * alinéas [0034], [0035]; figures 4, 6 *	1,2,4-6, 12,13	
A	US 2016/043272 A1 (DAMILANO BENJAMIN [FR] ET AL) 11 février 2016 (2016-02-11) * alinéas [0021] - [0030], [0059]; figures 1, 5 *	1,4-6, 12,13	
A	US 2010/294957 A1 (ALBRECHT TONY [DE] ET AL) 25 novembre 2010 (2010-11-25) * alinéas [0057] - [0083]; figures 1-4 *	1,4,5, 12,13	
A	US 2004/227144 A1 (HON SCHANG-JING [TW]) 18 novembre 2004 (2004-11-18) * alinéas [0038] - [0047], [0049], [0050], [0055], [0057]; figures 1-3,6,7,10,11,13,14 *	1,5,6, 12,13	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC) H01L
A	US 2006/054905 A1 (SCHWACH CAROLE [FR] ET AL) 16 mars 2006 (2006-03-16) * alinéas [0054] - [0057], [0064] - [0067], [0071], [0074]; figures 5A-7 *	1,4,12, 13	
A	US 2010/090232 A1 (HUANG SHIH CHENG [TW] ET AL) 15 avril 2010 (2010-04-15) * alinéas [0038] - [0050]; figures 1, 7-9 *	1,10,12, 13	
----- -/--			
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
18 janvier 2018		Tinjod, Frank	
<p>CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

1
EPO FORM 1503 12.99 (P04C14)



**RAPPORT DE RECHERCHE
PRÉLIMINAIRE**

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 842393
FR 1753842

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A	US 2006/124917 A1 (MILLER THOMAS J [US] ET AL) 15 juin 2006 (2006-06-15) * alinéas [0027], [0030] - [0033]; figures 1-4; tableau 1 *	1,4,10, 12	
A	US 2013/050810 A1 (SCHUBERT MARTIN F [US] ET AL) 28 février 2013 (2013-02-28) * alinéas [0001], [0020], [0036]; figures 2, 7 *	1,12,13	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
		Date d'achèvement de la recherche	Examineur
		18 janvier 2018	Tinjod, Frank
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

1

EPO FORM 1503 12.99 (P04C14)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 1753842 FA 842393**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 18-01-2018

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 2013049569 A1	28-02-2013	TW 201316563 A	16-04-2013
		US 2013049569 A1	28-02-2013
		US 2016211423 A1	21-07-2016
		WO 2013028366 A1	28-02-2013

US 2011045623 A1	24-02-2011	EP 1994571 A1	26-11-2008
		FR 2898434 A1	14-09-2007
		JP 2009530803 A	27-08-2009
		KR 20080104368 A	02-12-2008
		US 2009101934 A1	23-04-2009
		US 2011045623 A1	24-02-2011
		WO 2007104884 A1	20-09-2007

US 2016043272 A1	11-02-2016	CN 105122475 A	02-12-2015
		EP 2973754 A1	20-01-2016
		FR 3003402 A1	19-09-2014
		JP 2016513878 A	16-05-2016
		US 2016043272 A1	11-02-2016
		WO 2014140118 A1	18-09-2014

US 2010294957 A1	25-11-2010	CN 101809764 A	18-08-2010
		DE 112008003200 A5	16-09-2010
		EP 2193550 A1	09-06-2010
		JP 5289448 B2	11-09-2013
		JP 2010541217 A	24-12-2010
		KR 20100059854 A	04-06-2010
		US 2010294957 A1	25-11-2010
		WO 2009039815 A1	02-04-2009

US 2004227144 A1	18-11-2004	JP 2004153271 A	27-05-2004
		TW 586246 B	01-05-2004
		US 2004227144 A1	18-11-2004

US 2006054905 A1	16-03-2006	US 2006054905 A1	16-03-2006
		WO 2006036446 A2	06-04-2006

US 2010090232 A1	15-04-2010	TW 201015751 A	16-04-2010
		US 2010090232 A1	15-04-2010
		US 2012190141 A1	26-07-2012

US 2006124917 A1	15-06-2006	CN 101076897 A	21-11-2007
		EP 1831934 A1	12-09-2007
		JP 5059617 B2	24-10-2012
		JP 2008523615 A	03-07-2008
		KR 20070093092 A	17-09-2007
		TW 200637032 A	16-10-2006

EPO FORM P0465

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 1753842 FA 842393**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **18-01-2018**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
		US 2006124917 A1	15-06-2006
		US 2007051967 A1	08-03-2007
		US 2008272362 A1	06-11-2008
		US 2008272387 A1	06-11-2008
		US 2010155694 A1	24-06-2010
		WO 2006062588 A1	15-06-2006

US 2013050810 A1	28-02-2013	TW 201316562 A	16-04-2013
		US 2013050810 A1	28-02-2013
		WO 2013036346 A2	14-03-2013
